



## «КРЕМНИЙ-2014»

**X Конференция и IX Школа молодых ученых и специалистов по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе.**

Конференция «Кремний-2014» является продолжением серии научных конференций посвященных кремнию. Свою историю она ведет с общероссийского совещания по кремнию, проведенного в МИСиС в 1999 году. С 2000 года параллельно с конференцией проводится Школа для молодых ученых и специалистов. За эти годы мероприятие превратилось в основной форум, где ученые, представляющие академическое сообщество, ВУЗы и промышленность России и стран СНГ, могут обсудить актуальные проблемы по всему кругу вопросов, включающему в себя получение металлургического и поликристаллического кремния, рост и материаловедение объемных кристаллов и тонких пленок кремния и родственных материалов, а также физику, технологию и диагностику наноструктур на их основе.

В рамках Школы будут прочитаны лекции, целью которых является ознакомить молодых ученых и студентов с наиболее важными и актуальными проблемами в области получения кремния и создания современных приборов на его основе. На конференции будут представлены приглашенные доклады ведущих ученых, работающих в области материаловедения кремния и его применений, а также устные и стендовые доклады. Для конференций, проводящихся в Иркутске, стало традиционным включать в тематику проблемы получения и очистки металлургического кремния и создания на его основе материала для производства солнечных батарей, а так же другие аспекты альтернативной энергетики на базе прямого преобразования солнечного света в электрическую энергию.

### **Организаторы конференции:**

***Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН;***

### **Основные темы конференции:**

1. Методы получения и очистки металлургического кремния.
2. Получение кремния солнечного качества и проблемы солнечной энергетики.
3. Процессы роста из расплава.
4. Рост и материаловедение объемных кристаллов кремния и родственных материалов (Ge, SiGe);
5. Производство полупроводникового поликремния и структур на его основе;
6. Рост и материаловедение тонких (в том числе эпитаксиальных) пленок на кремнии, включая кремний-на-изоляторе и напряженные структуры;
7. Физика кремниевых квантово-размерных структур твердотельной электроники, в том числе нано- и оптоэлектроники, спинтроники и фотоники;
8. Нанотехнологии кремниевой электроники, включая ионную имплантацию, литографию, технологии создания квантовых точек и скрытых слоев;
9. Диагностика кремния и приборных структур на его основе;
10. Новые приборы, включающие элементы микромеханики, оптоэлектроники, силовой электроники, светоизлучающие структуры и фотоприемники.
11. Методы и аппаратура для роста и исследования кремния.

### **Контрольные сроки**

Срок представления тезисов	до 31 марта
Индивидуальное извещение о включении доклада и его статусе в программу Конференции	14 мая
Рассылка третьего информационного письма	9 июня

Конференция продлится с 7 по 12 июля 2014 года. Для желающих в программу Конференции будет включена экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (<http://kbzd.transsib.ru/>). Оргкомитет организует встречу участников конференции в г. Иркутске, трансферт до места проведения конференции и возвращение участников, после окончания Конференции, в Иркутск.

Тезисы, оформленные в соответствии с шаблоном (Abstract.doc), размещённой на сайте конференции, будут приниматься в электронном виде в личном кабинете участника конференции по адресу <http://conf.nsc.ru/si2014/ru/> до 31 марта 2014 г.

### **Рамочная программа Совещания**

<b>Заезд участников:</b>	7 июля (до обеда)
<b>Открытие Совещания:</b>	7 июля в 14 <sup>00</sup>
<b>Рабочие сессии:</b>	7– 10 июля
<b>Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге</b>	11 июля
<b>Выезд:</b>	12 июля

**Организационный взнос** в размере 8000 рублей включает в себя: публикацию тезисов, материалы Конференции, информационные и транспортные услуги, трехразовое питание и банкет.

**Способ оплаты:** Оплата организационного взноса будет производиться по безналичному расчёту или при регистрации участников Конференции.

### **Реквизиты Института для безналичного расчёта:**

**Полное наименование:** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук

**Сокращенное наименование:** ИГХ СО РАН

**Адрес:** 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1А

**ИНН:** 3812011717/ **КПП:** 381201001

УФК по Иркутской области (ИГХ СО РАН л/сч 20346Ц36730)

р/сч 40501810000002000001 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ИРКУТСК

**БИК:** 042520001; **ОКТМО** – 25701000; **ОКПО** – 03533702; **ОКВЭД** – 73.10; **ОГРН** – 1023801760564

**Директор** Член-корреспондент РАН Шацкий Владислав Станиславович

### **Форма докладов:**

1. Пленарные - 25 мин.
2. Устные - 15 минут.
3. Стендовые – размер стенда 1x1.5 м

**Язык Конференции:** Русский и английский

### **Материалы Конференции:**

Статьи докладов Конференции предполагается издать в журналах «Физика и Техника Полупроводников» и Известия ВУЗов «Материалы электронной техники». Статьи, оформленные в соответствии с требованиями журналов, необходимо представить в Оргкомитет при регистрации в электронном виде. Рекомендации по журналам будут даны Оргкомитетом авторам.

**Информация по проживанию**

Местом проведения Конференции выбрана гостиница Прибайкальская (<http://pribaikalskaja.ru/>), расположенная в живописном месте вблизи озера Байкал у истока Ангары.

Стоимость проживания.

<b>Номер</b>	<b>Цена</b>
Одноместный номер стандартный	2250
Одноместный номер с видом на Ангару	2500
Двухместный номер стандартный	3300
Двухместный номер с видом на Ангару	3400
Двухместный номер ст. (для одного проживающего)	2700
Двухместный номер с видом на Ангару (для одного проживающего)	2800
Семейный номер с завтраком на двоих	4500
Семейный номер (для одного проживающего)	4150
Полулюкс с завтраком на двоих	4500
Полулюкс (для одного проживающего)	4150
Люкс с завтраком на двоих	5200
Люкс (для одного проживающего)	4900
Дополнительная кровать (раскладушка) с завтраком	1000